

Кремниевый квадрантный PIN фотодетекторный чип — техническое описание

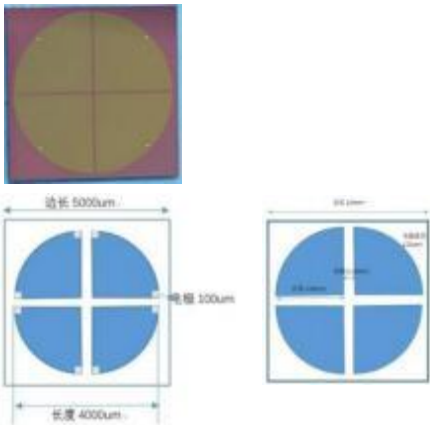
P/N : WS9I-02C

Применение

Si PIN фотодиодный чип

Структура

Планарная структура: PIN-диод; электроды: задняя сторона (катод) — Au, верхняя сторона (анод) — Al



ГАБАРИТЫ

Габариты	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.	Примечания
Активная область	9			мм	
Ширина чипа	10			мм	5 мм: 01C 10 мм: 02C 16 мм: 03C
Длина чипа	10			мм	
Высота чипа	290	305	320	мкм	
Размер контактной площадки		120		мкм	

Электрооптические характеристики (при Ta=25 °C)

Параметр	Обозначение	Условия измерения	Мин.	Тип.	Макс.	Ед. изм.
Прямое напряжение	Vf	If=10mA, H=0	0.7		1.3	В
Обратное напряжение	Vbr	Ir=100μA, H=0	150			В
Обратный темновой ток	Id	Vr=50V			10	нА
Чувствительность (на квадрант)	Rei	Vr=50V	0.3			А/Вт
Рабочий диапазон длин волн	λ		400	1064	1100	нм
Емкость (чип)	Cj	VR=0V, f=1MHz		150		пФ